

пропицаемость, m^* — эффективная масса носителей, N — концентрация примесей, $\Phi(x) = \ln(1+x) - x/(1+x)$, где $x = 8m^*E/q^2$, q — величина, обратная дебаевско-му радиусу экранирования. Из Б.—Х. ф. следует, что рассеяние на ионизованных примесях становится более эффективным при малых энергиях носителей и, следовательно, при низких темперах.

Б.—Х. ф. получена в борновском приближении теории столкновений с учётом экранирования примесей свободными носителями. При её выводе предполагается, что примеси расположены в кристаллической решётке беспорядочно (см. *Рассеяние носителей заряда*).

Лит.: Brooks H., Scattering by ionized impurities in semiconductors, «Phys. Rev.», 1951, v. 83, p. 879; его же, Theory of the electrical properties of Germanium and Silicon, в кн.: Advances in electronics and electron physics, ed. by L. Merton, v. 7, N.Y., 1955, p. 83; Бонч-Бруевич В. Л., Казашников С. Г., Физика полупроводников, М., 1977; Зесегер К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977.

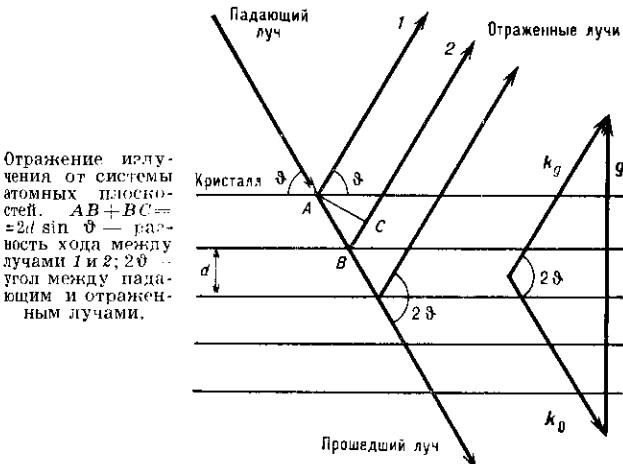
Э. М. Эштейн.

БРУС в сопротивлении материалов — деформируемое твёрдое тело, поперечные размеры к-го много меньше продольного. Линия, соединяющая центры тяжести поперечных сечений Б., наз. осью Б. В зависимости от формы Б. могут быть ломаные, кривые; если ось Б. прямолинейна, Б. наз. прямым. Прямой Б. пуст. сечение наз. стержнем, Б., работающим на изгиб, — балкой.

Б. часто встречаются в качестве элемента конструкции, сооружения или машины, поэтому разработаны спец. методы расчёта напряжений и деформаций Б. Типичной для расчёта Б. является гипотеза плоских и кривых сечений: при растяжении, сжатии, кручении или изгибе Б. его поперечное сечение, составленное из материальных частиц, остаётся плоским и перпендикулярным деформированной оси Б. (см. *Изгиб, Кручение*). В ряде случаев сложную конструкцию удлинённой формы (корабль, крыло самолёта, телебашни и др.) для оценки суммарных деформаций также рассчитывают как Б.

Б. С. Ленский.

БРЭГГА — ВУЛЬФА УСЛОВИЕ — определяется направление возникновения дифракц. максимумов упруго рассеянного на кристалле рентг. излучения. Выведено в 1913 независимо У. Л. Брэггом (W. L. Bragg) и



Г. В. Вульфом. Если кристалл рассматривать как совокупность параллельных атомных плоскостей, отстоящих друг от друга на расстоянии d , то процесс дифракции можно представить как отражение излучения от системы этих плоскостей. Максимумы интенсивности (дифракционные максимумы) возникают при этом только в тех направлениях, в к-рых все отражённые данной системой атомных плоскостей волны имеют одинаковые фазы. Это возможно, если разность хода $AB + BC$ между двумя отражёнными от соседних

плоскостей волнами, равная $2d \sin \theta$ (рис.), кратна целому числу длин волн λ . Т. о., Б.—В. у. имеет вид:

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad (1)$$

где целое положит. число n наз. порядком отражения, θ — угол скольжения падающего луча. Если θ удовлетворяет условию (1), то он наз. углом Брэгга. Дифракц. луч распространяется под углом 2θ к первичному лучу. Б.—В. у. для каждой данной системы атомных плоскостей можно получить из общих условий интерференции на трёхмерной решётке, выбирая соответствующим образом систему координат (см. *Дифракция рентгеновских лучей*).

Б.—В. у. позволяет определять межплоскостные расстояния d в кристалле, т. к. λ обычно известна, а углы θ измеряются экспериментально. Условие (1) получено без учёта эффекта преломления для безграничного кристалла, имеющего идеально-периодическое строение. В действительности дифрагированное излучение распространяется в конечном угловом интервале $\theta \pm \Delta\theta$, причём ширина этого интервала определяется в кинематич. приближении числом отражающих атомных плоскостей (т. е. пропорциональна линейным размерам кристалла), аналогично числу штрихов дифракционной решётки. При динамич. дифракции величина $\Delta\theta$ зависит также от величины взаимодействия рентгеновского излучения с атомами кристалла (см. *Ноялизация рентгеновская*). Искажения решётки кристалла в зависимости от их характера ведут к изменению угла θ или возрастанию $\Delta\theta$, или к тому и другому одновременно.

Б.—В. у. является исходным пунктом исследований в рентгеновском структурном анализе, рентгенографии материалов, рентгеновской топографии.

Б.—В. у. можно дать наглядную векторную трактовку. Дифракция возникает при выполнении условия (рис.):

$$k_g = k_0 + g, \quad (2)$$

где k_g , k_0 — волновые векторы первичной и дифрагированной волн соответственно, g — вектор обратной решётки; $|k_0| = |k_g|$, $|g| = 2\pi/d$. Условие (2) выражает закон сохранения квазимпульса в периодич. среде и эквивалентно условию (1).

Б.—В. у. остается справедливым при дифракции γ-излучения, электронов и нейтронов в кристаллах (см. *Дифракция частиц*), при дифракции в слоистых и периодич. структурах излучения радио- и оптического диапазонов, а также звука.

В нелинейной оптике и квантовой электронике при описании параметрических и неупругих процессов применяются разл. условия пространственного синхронизма волн, близкие по смыслу Б.—В. у. А. В. Колпаков.

БРЭГГОВСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ — схемы дифракции рентгеновских лучей, при к-рой падающий и дифракционный луч лежат по одну сторону от поверхности кристалла (рис. а). В том случае, когда падающий и дифракционный лучи находятся по разные стороны кристаллической пластины (рис. б), имеет место яз. э. в. с. прохождение (Л. п.). Если угол ϕ между системой атомных плоскостей, находящихся в отражающем положении, и входной поверхностью кристалла равен нулю, то Б. о. наз. симметричным, в остальных случаях — асимметричным. При $\phi = \pi/2$ имеет место симметричное Л. п.

Б. о. и Л. п. являются простейшими фундам. задачами динамич. дифракции рентг. лучей, полностью выявляющими её осн. особенности. Введение в рассмотрение схем Б. о. и Л. п. имеет смысл только для двухлучевой динамич. дифракции. При многолучевой дифракции одновременно имеются и отражённые и пропущенные дифракц. лучи, к-рые могут взаимодействовать, что не позволяет выделять к-л. простейшие схемы. При кинематич. дифракции, когда обратным влиянием